










| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">JANTXV1N5809</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | JANTXV1N5809 |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL |
| Datenblätter: |  JANTXV1N5809.pdf | |
| RoHs Status: | Enthält Blei / RoHS nicht konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | JANTXV1N5809 |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 875mV @ 4A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 100V |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/477 |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 30ns |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | B, Axial |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -65°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 5µA @ 100V |
| Strom - Richt (Io) | 3A |
| Kapazität @ Vr, F | 65pF @ 10V, 1MHz |

JANTXV1N5809 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N5809-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N5809 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JANTXV1N5809 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>JANTXV1N5807URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG</p> |  <p>JANTXV1N5811 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A AXIAL</p> |  <p>JANTXV1N5811US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A B-MELF</p> |   <p>JANTXV1N5806US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A D5A</p> |
|  <p>JANTXV1N5806URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A APKG</p> |  <p>JANTXV1N5809URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p> |  <p>JANTXV1N5811URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG</p> |  <p>JANTXV1N5809US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| JANTXV1N5809 Microsemi | JANTXV1N5809 Datenblatt | JANTXV1N5809-Datenblätter | JANTXV1N5809 PDF | Microsemi JANTXV1N5809 |
| JANTXV1N5809 Electronic | JANTXV1N5809-Komponenten | JANTXV1N5809-Verteiler | JANTXV1N5809-Bild | JANTXV1N5809-Teil |
| JANTXV1N5809 Preis | JANTXV1N5809 Hersteller | JANTXV1N5809 Bild | JANTXV1N5809 Aktie | JANTXV1N5809 Inventar |
| JANTXV1N5809 Neu | JANTXV1N5809 Original | JANTXV1N5809 garantiert | JANTXV1N5809 RFQ | JANTXV1N5809 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited